

СОЛИТОНЫ ДЕФОРМАЦИИ В СРЕДАХ
С НЕЛИНЕЙНОЙ УПРУГОСТЬЮ,
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД

В. И. Сериков, С. В. Воронин

Наличие солитонных решений [1] релаксационного уравнения Гинзбурга—Ландау

$$\dot{\eta} = \mathcal{L} [-A\eta - B\eta^3 + D(\partial^2\eta/\partial x^2)] \quad (1)$$

порождает проблему поиска таких решений, которые не могут быть получены методами линеаризации, для тех случаев, когда уравнение движения параметра порядка η (1) рассматривается совместно с другими уравнениями.

Одним из весьма распространенных случаев в акустике сегнетоэлектриков и ферромагнетиков является совместное рассмотрение уравнения (1) с уравнением движения деформаций. При этом наиболее часто реализуется квадратичная связь параметра порядка η с деформациями (квадратичная стрикция). В области фазового перехода в уравнении движения деформаций необходимо учитывать не только члены, квадратичные по параметру порядка, но и члены, квадратичные по деформациям. С учетом нелинейных членов уравнения движения параметра порядка η и деформации ϵ можно представить в форме

$$\begin{aligned} \eta_t &= \mathcal{L} (-A\eta - B\eta^3 + D\eta_{xx} + g\eta\epsilon), \\ \rho\epsilon_{tt} - \kappa\epsilon_{xt} - c\epsilon_{xx} &= c\Gamma(\epsilon_x^2 + \epsilon\epsilon_{xx}) - g(\eta_x^2 + \eta\eta_{xx}). \end{aligned} \quad (2)$$

Здесь B , D — коэффициенты, которые можно считать температурно-независящими в области фазового перехода; $A = A_0(T - T_c)$, где T_c — температура Кюри; g — коэффициент стрикции; \mathcal{L} — кинетический коэффициент; ρ — плотность среды; c — модуль упругости; κ — феноменологически вводимый коэффициент поглощения; Γ — нелинейный акустический параметр.

Решение системы уравнений (2) ищем в виде

$$\eta = \eta_0 \left[\text{th} \left(\frac{x - Vt}{\Delta} \right) - 1 \right], \quad \epsilon = \epsilon_0 \left[\text{th} \left(\frac{x - Vt}{\Delta} \right) - 1 \right]. \quad (3)$$

Действуя в духе работы [1], систему уравнений, определяющих скорость V , ширину Δ , коэффициент поглощения κ и амплитуды η_0 , ϵ_0 солитонов, можно записать в форме

$$V = \mathcal{L}\Delta \left(-\frac{A}{2} + \frac{2D}{\Delta^2} \right), \quad \Delta^2 = \frac{2D}{B\eta_0^2}, \quad \kappa = \frac{c - \rho V^2}{V}, \quad (4)-(6)$$

$$\eta_0^2 \pm \frac{\eta_0 g^{3/2}}{4B\sqrt{c\Gamma}} + \frac{A}{4B} = 0, \quad (7)$$

$$\epsilon_0^2 \pm \frac{\epsilon_0 g^2}{4Bc\Gamma} + \frac{Ag}{4Bc\Gamma} = 0. \quad (8)$$

При $T \rightarrow T_c$, $A \rightarrow 0$ уравнения (7), (8) имеют ненулевые решения

$$\eta_0 = \mp \frac{g^{3/2}}{4B\sqrt{c\Gamma}}, \quad \epsilon_0 = \mp \frac{g^2}{4Bc\Gamma}, \quad (9)$$

так что ширина и скорость солитона остаются конечными

$$\Delta = \frac{4\sqrt{2Dc\Gamma B}}{g^{3/2}}, \quad V = \frac{8\mathcal{L}D^{3/2}\sqrt{2c\Gamma}}{g^{3/2}}. \quad (10)-(11)$$

Следует отметить, что рассмотренные решения имеют смысл в области перехода лишь в том случае, когда $g/(c\Gamma) > 0$.

Л и т е р а т у р а

[1] Мелькер А. И., Овидько Н. А. ФТТ, 1985, т. 27, № 2, с. 594--597.

Липецкий политехнический институт
Липецк

Поступило в Редакцию
3 марта 1988 г.

УДК 539.292

Физика твердого тела, том 30, в. 9, 1988
Solid State Physics, vol. 30, № 9, 1988

ЭЛЕКТРОННОЕ ТУННЕЛИРОВАНИЕ В НЕОДНОРОДНЫЕ СВЕРХПРОВОДНИКИ

М. А. Белоголосский, А. И. Дьяченко

Туннельная спектроскопия сверхпроводников с малой фермиевской скоростью и, в частности, нахождение энергетической щели методом электронного туннелирования представляют собой определенную проблему [1]. Дело в том, что длина свободного пробега электрона в таких материалах оказывается сравнительно небольшой (десятки ангстрем). Поэтому фактически в экспериментах по туннелированию в такие металлы измеряются не объемные свойства, а характеристики поверхностного слоя с пониженным параметром порядка. Особые трудности возникают при исследовании открытых недавно металлооксидных сверхпроводников с высокими критическими параметрами, сложные туннельные характеристики которых имеют неоднозначную интерпретацию (см., например, [2]). Иногда для устранения отмеченного недостатка преднамеренно создают туннельные контакты, в которых между исследуемым сверхпроводником и изолятором находится тончайшая прослойка нормального металла [1]. В описанных ситуациях в окрестности барьера возникает координатная зависимость параметра порядка, которая ведет к искажению вида туннельных характеристик по сравнению с туннелированием в однородный сверхпроводящий образец. В настоящей работе исследуется проблема нахождения величины энергетической щели Δ_1 изучаемого сверхпроводника S_1 из данных по электронному туннелированию в слоистых структурах S_2-I-N типа (S_2 — сверхпроводящий инжектор, I — изолятор, N — нормальный слой).

Для таких структур с малой прозрачностью барьера (именно они используются на эксперименте) зависимость туннельного тока J от приложенного напряжения U имеет вид [3]

$$J(U) = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega \int_0^1 d(\cos\theta) D(\cos\theta) N_T^{(2)}(\omega - U) N_T^{(1)}(\omega, \cos\theta) [f(\omega - U) - f(\omega)], \quad (1)$$

где функция $D(\cos\theta)$ описывает угловую зависимость вероятности туннелирования электрона; туннельная плотность состояний исследуемого сверхпроводника $N_T^{(1)}(\omega, \cos\theta)$ пропорциональна мнимой части электронной функции Грина; соответствующая функция для инжектора описывается стандартной формулой $N_T^{(2)}(\omega) = \text{Re}\{\omega \sqrt{\omega^2 - \Delta_2^2}\}$; Δ_2 — энергетическая щель инжектора; $f(\omega)$ — функция распределения Ферми; $U = eV$.

На основе результатов работы [3] в приближении зеркального туннелирования было рассчитано характерное поведение интеграла $N_T(\omega) =$